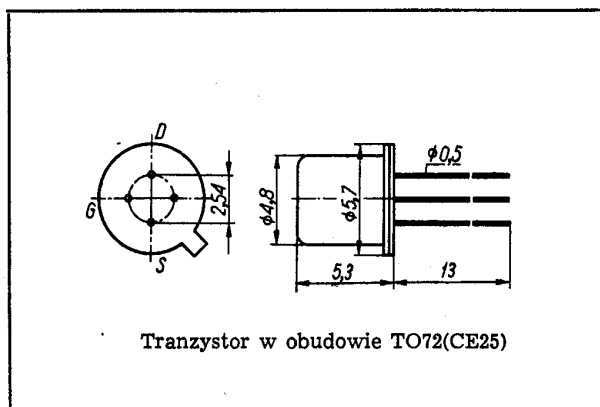


Tranzystor krzemowy polowy MOS epiplanarny z kanałem typu p wzbogacanym, z izolowaną bramką. Jest przeznaczony do stosowania w układach przełączających małej mocy oraz w układach o dużej impedancji wejściowej.



DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Napięcie ujęcie-źródło	$-U_{DS}$	25	V
Napięcie bramka-źródło	U_{GS}	± 20	V
Prąd ujęcia	I_D	500	mA
Moc strat	P	250	mW
Temperatura kanału	t_{ch}	423 (150)	K °C

SWW 1156-21

Zakres temperatury otoczenia

t_{amb}	233...373 (-40...+100)	K °C
-----------	---------------------------	---------

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		<u>min.</u>	<u>maks.</u>	
Prąd upływu bramki przy $U_{GS} = 20$ V, $U_{DS} = 0$	I_{GSS}	—	100	pA
Napięcie progowe bramki przy $I_D = -10$ μ A, $U_{DG} = 0$	$-U_{GS(TO)}$	4	14	V
Prąd upływu ujęcia przy $U_{DS} = -15$ V, $U_{GS} = 0$	I_{DSS}	—	5	nA
przy $U_{DS} = -15$ V, $U_{GS} = 0$, $t_{amb} = 373$ K (100°C)	I_{DSS}	—	2	μ A

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)		<u>min.</u>	<u>maks.</u>	
Konduktancja przejściowa przy $I_D = 5$ mA, $U_{DG} = 0$	g_m	1	—	mS
Rezystancja kanału przy $I_D = 1$ mA, $U_{GS} = -20$ V	$r_{DS(on)}$	—	700	Ω
przy $U_{DS} = -15$ V	$r_{DS(off)}$	300	—	M Ω

PRODUCENT i DYSTRYBUTOR



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
PÓLPRZEWODNIKÓW

Zakład Doświadczalny Półprzewodników przy ITE
ul. Komarowa 5, 02-675 Warszawa
telefon: 431431 do 39, teleks: 813219



LittleDiode supplies new, hard to find or obsolete electronic components and semiconductors all over the world.

With over two million different components listed you are sure to find the part you need.

Feel free to visit us today at our online store:

LittleDiode.com

Looking forward to providing you with the best possible service.